

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника
в секторе Теории оптических и электрических явлений в полупроводниках
Вакансия VAC_37224

Тематика исследований

Исследования в области теории физики твердого тела, в том числе, изучение оптических и ультразвуковых резонансных и релаксационных переходов между состояниями носителей заряда в полупроводниках с учетом электрон-фононного взаимодействия и расщепления собственных состояний носителей заряда во внешнем постоянном магнитном поле.

Трудовая деятельность

Проведение научных исследований и разработок под руководством заведующего сектором согласно государственному заданию и планам НИР по утверждённым целевым программам. Разработка аналитических и численных методов исследования релаксационных процессов и резонансных внутрицентровых переходов под действием упругих волн и оптического излучения в глубоких точечных дефектах в полупроводниках АЗВ5 и А2В6 типов. Сбор и обработка научной информации, необходимой для решения исследовательских задач. Формулировка выводов по итогам проведенных исследований. Выступление с докладами на научных семинарах и конференциях, подготовка публикаций по результатам исследований.

Особенности трудовой деятельности

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в секторе Теории оптических и электрических явлений в полупроводниках на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к их квалификации.

- Ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «физика полупроводников».
- Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений: не менее 26
- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:
Web of Science (шт.) не менее 7, Scopus (шт.) не менее 8, РИНЦ (шт.) не менее 8.
- Опыт научной работы: не менее 7 лет.
- Индекс Хирша не ниже 3.
- За последние 5 лет: участие в не менее чем 10 проектах, поддержанных отечественными или зарубежными научными фондами; личное участие с докладами в не менее чем 5 российских или международных конференциях и семинарах.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).